DIALOG(R) File 351: Derwent WPI (c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011031357 **Image available**
WPI Acc No: 1997-009281/ 199701

XRAM Acc No: C97-002326 XRPX Acc No: N97-008479

Projection pattern transfer equipment for photolithography - in which inert gas supply line is connected to light path of optics system

Patent Assignee: NIKON CORP (NIKR)

Inventor: MURAYAMA M; OZAWA H

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 8279458 19961022 JP 95108177 A Α 19950407 199701 B US 634100<u>6</u> US 96628452 B1 20020122 Α 19960405 200208 US 97972434 19971118 Α US 98207270 Α 19981208 US 99422862 Α 19991025

Priority Applications (No Type Date): JP 95108177 A 19950407; JP 95108178 A 19950407; JP 97337105 A 19971208

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 8279458 A 8 H01L-021/027

US 6341006 B1 G03B-027/42

Cont of application US 96628452 CIP of application US 97972434 Cont of application US 98207270

Abstract (Basic): JP 8279458 A

An inert gas supply line is connected to the light path of the projection optics system.

ADVANTAGE - Light fluctuation in the light path can be avoided. ${\rm Dwg.}\,1/4$

Title Terms: PROJECT; PATTERN; TRANSFER; EQUIPMENT; PHOTOLITHOGRAPHIC; INERT; GAS; SUPPLY; LINE; CONNECT; LIGHT; PATH; OPTICAL; SYSTEM

Derwent Class: G06; L03; P82; P84; U11

International Patent Class (Main): G03B-027/42; H01L-021/027

International Patent Class (Additional): G03F-007/20

File Segment: CPI; EPI; EngPI

Manual Codes (CPI/A-N): G06-D04; G06-G18; L04-C06; L04-D10

Manual Codes (EPI/S-X): U11-C04E1

			•	3	•
					*
÷					

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-279458

(43)公開日 平成8年(1996)10月22日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H 0 1 L 21/027			H 0 1 L 21/30	516F
G 0 3 F 7/20	5 2 1		G 0 3 F 7/20	5 2 1

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 8 頁)

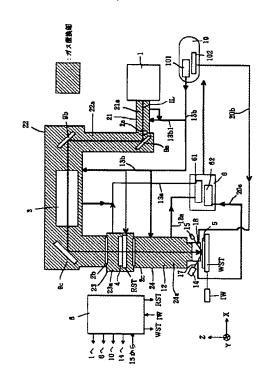
		The second of th
(21)出顧番号	特願平7-108177	(71)出願人 000004112
		株式会社ニコン
(22)出願日	平成7年(1995)4月7日	東京都千代田区丸の内3丁目2番3号
		(72)発明者 村山 正幸
		東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株
		式会社ニコン内
		(74)代理人 弁理士 山口 孝雄

(54) 【発明の名称】 投影露光装置

(57) 【要約】

【目的】 遠紫外光を露光に使用しても、酸素による露光光の吸収の影響を殆ど受けず、かつ各種光学的計測センサの計測光の光路近傍の雰囲気の揺らぎの影響のない投影露光装置を提供すること。

【構成】 酸素に対して吸収特性を有する波長域を含む 照明光 (中心波長193.4nm, 193.0nm~1 93.8 nm程度の波長幅を有する光、もしくは中心波 長193. 4nm, 数十pmの波長幅に狭帯化された光 IL)を射出する光源(I)と、パターンが形成された マスク(4)に光源からの光を照射するための照明光学 系(9 a ~ 9 c 、 3 等)と、照明されたパターンの像を 基板(5)上に形成するための投影光学系(12)とを 有する投影露光装置において、照明光学系及び投影光学 系の光路内に照明光の波長域に対して酸素より吸収特性 の小さな不活性ガスを供給するガス供給系(10)と、 投影光学系の基板側端部から基板の近傍までの空間に、 空間内の照明光の光路中に存在する大気のほぼ全体を酸 素以外の物質(窒素等の不活性ガス)で置換するための 密閉部材(18)を配置した。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 酸素に対して吸収特性を有する波長域を含む照明光を射出する光源と、バターンが形成されたマスクに前記光源からの光を照射するための照明光学系と、前記照明されたバターンの像を基板上に形成するための投影光学系とを有する投影露光装置において、

1

前記照明光学系及び前記投影光学系の光路内に前記照明 光の波長域に対して前記酸素より吸収特性の小さな不活 性ガスを供給するガス供給系と、

前記投影光学系の前記基板側端部から前記基板の近傍ま 10 という不都合があった。 での空間に、該空間内の前記照明光の光路中に存在する [0004] このため、 大気のほぼ全体を酸素以外の物質で置換するための密閉 露光装置では、照明光等 部材を配置したことを特徴とする投影露光装置。 大気から遮断した密閉

【請求項2】 前記密閉部材は、前記照明光を透過する 透明部材で構成されることを特徴とする請求項1記載の 投影露光装置。

【請求項3】 前記密閉部材は、前記空間を大気から密閉する隔壁と前記照明光を透過する透明部材とを有し、前記ガス供給系は、前記隔壁と前記透明部材とで構成される密封空間に前記不活性ガスを供給することを特徴と 20 する請求項1記載の投影露光装置。

【請求項4】 前記投影露光装置は、前記密閉部材によって形成された密閉空間を介して基板表面に斜めから計測光を入射し、前記基板からの反射光を密閉空間を介して受光することによって前記基板の高さ位置を光学的に検出する焦点検出系を有し、

前記密閉部材は、前記基板に向かって入射する計測光を 透過する第1光透過部と、前記基板表面で反射された前 記計測光を透過する第2光透過部とを有することを特徴 とする請求項3記載の投影露光装置。

【請求項5】 前記透明部材は前記投影光学系の結像特性を調整する調整部材であることを特徴とする請求項3 記載の投影露光装置。

【請求項6】 前記ガス供給系は、前記不括性ガスを前記密閉部材内に供給するとともに、前記密閉部材内の前記不活性ガスの屈折率を調整することを特徴とする請求項1記載の投影露光装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は投影露光装置に関し、特 40 に半導体素子(IC、CCD等)、液晶表示素子、薄膜磁気ヘッド等をリソグラフィ工程で製造する際に使用される投影露光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】半導体素子の大集積化の要望は年々高くなっており、要求される回路パターンのパターンルール (線幅) は小さくなっている。投影光学系が解像できる線幅は波長に比例して小さくなることが知られており、より小さなパターンルールの回路パターンを露光するためには露光に使用する光の波長を短くすれば良い。最近 50

ではArFを媒体としたエキシマレーザ(波長193nm)を使った投影露光装置が提案されている。

【0003】ArFを媒体としたエキシマレーザからのレーザ光のように、約200nm以下の波長の光(以下、「遠紫外光」という)は、酸素に対して吸収特性を有する波長域(スペクトル成分)を含んでおり、大気中の酸素による吸収が大きい。遠紫外光が酸素に吸収されることによって、遠紫外光の光量が損失されるとともに、吸収の際に有害ガスであるオゾンが発生してしまうよいる不知会があった

[0004] このため、遠紫外光を使用する従来の投影 露光装置では、照明光学系から投影光学系までの光路を 大気から遮断した密閉型とし、密閉空間内の大気を不活 性ガスに置換していた。そして投影光学系とウエハとの間の空間を密閉することなく、不活性ガスを露光光の光路中に吹きつけることにより、投影光学系とウエハとの間の空間をガス置換していた(特開平6-260385号公報)。

[0005]

20 【発明が解決しようとする課題】上述したような従来の投影露光装置には、通常ウエハに斜めから計測光を入射して、その反射光を受光することによりウエハの高さ位置を計測する焦点検出系(特開昭60-168112号公報に詳しく開示されている)やウエハのマークにアライメント光を照射してマークからの回折、散乱光を受光することによりウエハの位置を計測するアライメント系やウエハを載置するウエハステージに設けられた移動鏡にレーザ光を照射し、その反射光を受光してウエハステージの位置を計測するレーザ干渉計が設けられている(アライメント系とレーザ干渉計は特開昭60-186845号公報に詳しく開示されている)。

【0006】このような従来の投影露光では、投影光学系とウエハとの間に不活性ガスを吹きつけるとガス流速の変動等に起因して、雰囲気中に揺らぎが生じ、投影光学系とウエハとの間の空間もしくはその周辺を通過する計測光を使った各種計測系(焦点検出系、アライメント系、干渉計)の計測値に誤差が生じる可能性がある。

【0007】本発明は、前述の課題に鑑みてなされたものであり、遠紫外光を露光に使用しても、酸素による露光光の吸収の影響を殆ど受けず、かつ各種光学的計測センサの計測光の光路近傍の雰囲気の揺らぎの影響のない投影露光装置を提供することを目的とする。

[8000]

【課題を解決するための手段】本発明の第1の投影露光 装置では、酸素に対して吸収特性を有する波長域を含む 照明光(中心波長193.4nm,193.0nm~193.8nm程度の波長幅を有する光、もしくは中心波 長193.4nm,数十pmの波長幅に狭帯化された光 1L)を射出する光源(1)と、パターンが形成されたマスク(4)に光源からの光を照射するための照明光学

系(9a~9c、3等)と、照明されたパターンの像を 基板 (5) 上に形成するための投影光学系 (12) とを 有する投影解光装置において、照明光学系及び投影光学 系の光路内に照明光の波長域に対して酸素より吸収特性 の小さな不活性ガスを供給するガス供給系 (10) と、 投影光学系の基板側端部から基板の近傍までの空間に、 空間内の照明光の光路中に存在する大気のほぼ全体を酸 素以外の物質(窒素等の不活性ガス)で置換するための 密閉部材(18)を配置した。

【0009】また、本発明の第2の投影露光装置では、 照明光を透過する透明部材 (16c) で密閉部材を構成 することとした。また、本発明の第3の投影露光装置で は、密閉部材は、空間を大気から密閉する隔壁 (19) と照明光を透過する透明部材(16c)とを有し、ガス 供給系は、隔壁と透明部材とで形成される密閉空間に不 活性ガスを供給することとした。

【0010】本発明の第4の投影露光装置では、密閉部 材によって形成された密閉空間を介して基板表面に斜め から計測光を入射し、基板からの反射光を密閉空間を介 して受光することによって基板の高さ位置を光学的に検 20 出する焦点検出系(14、15)を有し、密閉部材は、 基板に向かって入射する計測光を透過する第1光透過部 (16a) と、基板表面で反射された計測光を透過する 第2光透過部(16b)とを有することとした。

【0011】本発明の第5の投影觀光装置では、透明部 材は投影光学系の結像特性を調整する調整部材であるこ ととした。本発明の第6の投影露光装置では、ガス供給 系は、不活性ガスを密閉部材内に供給するとともに、密 閉部材内の不活性ガスの屈折率を調整することとした。

[0012]

【作用】本発明の第1の投影露光装置によれば、露光光 に遠紫外光(酸素に対して吸収特性を有する波長域を含 む光)を使用しても、酸素による光の吸収、オゾンの発 生を最小限に抑えることができる。また、投影光学系と 基板との間の空間もしくはその近傍を各種計測光が通過 しても、揺らぎによる計測誤差が生じることがない。

【0013】また、本発明の第2の投影露光装置では、 照明光を透過する透明部材 (16c) で密閉部材を構成 することとしたので、不活性ガスを用いる必要がない。 また、本発明の第3の投影露光装置では、密閉部材は、 空間を大気から密閉する隔壁(19)と照明光を透過す る透明部材(16c)とを有し、ガス供給系は、隔壁と 透明部材とで形成される密封空間に不活性ガスを供給す ることとしたので、酸素による吸収の不都合が低減され

【0014】本発明の第4の投影露光装置では、密閉部 材に、基板に向かって入射する計測光を透過する第1光 透過部(16a)と、基板表面で反射された計測光を透 過する第2光透過部(16b)とを有することとしたの

使用できるとともに、焦点検出系に揺らぎによる計測誤 差が生じない。本発明の第5、第6の投影露光装置で は、酸素による露光光の吸収の問題の解決と投影光学系 の結像特性の調整とを同時に行える。

[0015]

【実施例】本発明の実施例を、添付図面に基づいて説明 する。図1は、本発明の実施例に好適な投影露光装置の 全体構成を概略的に示す図である。光源1は、遠紫外光 (ArFを媒体としたエキシマレーザ)を射出するもの 10 である。そして光源1にはエタロンや回折格子等を使っ TArFエキシマレーザ光を狭帯化する狭帯化部材が設 けられており、本実施例では波長193、4nmの光に 狭帯化されているものとする。

【0016】狭帯化を行うのは、遠紫外光が透過できる 光学硝子(石英や蛍石等)の加工や接着材の問題から広 帯域のエキシマレーザに対する投影光学系12 (図1) の色収差補正を良好に行うことは困難だからである。通 常はエタロンや回折格子等を使って波長幅を数十pm程 度まで狭帯化したレーザ光を用いて、投影光学系12の 色収差の問題が生じないようにしている。

【0017】その光源1(ArFを媒体としたエキシマ レーザ)から射出された露光光ILは、窓部2a(遠紫 外光を透過する光学部材、例えば石英等からなるガラス 板等)を透過した後、ミラー9aに入射する。ミラー9 aで図中上方に反射された露光光 I Lは、ミラー9bに よって図中左側に反射され、光学ユニット3に入射す る。光学ユニット3は、リレーレンズ、露光光 I L を均 一化するためのオプチカルインテグレータ(フライアイ レンズ等)、露光光ILをオプチカルインテグレータに 入射させるインプットレンズ、オプチカルインテグレー タから射出した露光光!Lをレチクル上に集光するため のリレーレンズ、コンデンサーレンズ等を有している。

【0018】光学ユニット3から射出された露光光ⅠL は、ミラー9 cによって図中下方向に反射される。ミラ -9cで反射された露光光 I Lは、窓部 2b (遠紫外光 を透過する光学部材、例えば石英等からなるガラス板 等)を透過し、ウエハ5上に露光すべきパターンが形成 されたマスク4に入射する。オプチカルインテグレータ とコンデンサーレンズ等がマスク4上での露光光ILの 照度をほぼ均一とするため、マスク4は露光光 I L によ りほぼ均一に照明される。マスク4を透過した露光光 I Lは、窓部2c (遠紫外光を透過する光学部材、例えば 石英等からなるガラス板等)、投影光学系12を介して ウエハ(感光基板)5に入射し、マスク4上のパターン の像をウエハ5上に形成する。

【0019】ウエハ5は、3次元方向(XY2方向)に 移動可能なウエハステージWST上に載置されている。 レーザ干渉系IWは、ウエハステージWSTのXY平面 内での位置を所定の分解能で計測する。ウエハステージ で、密閉部材を設けても光学的な斜入射の焦点検出系が 50 WSTは干渉系IWの計測値に基づいてステッピング移

40

助され、ステッピング移動と露光とを繰り返す、所謂ステッピングアンドリピート方式で、ウエハ5上にマスク4のパターンが逐次投影解光される。光源1から窓部2bまでの露光光ILの光路は、密閉部材21、22によって密閉され、マスク4は密閉部材23によって密閉されている。

【0020】また、投影光学系12は、通常複数枚のレンズエレメントとそれらを保持する鏡筒(1つまたは複数)で構成され、複数のレンズエレメントは鏡筒24によって外部(大気)からほぼ密閉されている(露光光ILの光路は鏡筒24によって密閉されている)。密閉部材21、22、23は特に限定されるものではなく、例えばアルミ等の金属で構成された筒状の密閉部材である。密閉部材21と密閉部材22とは窓部2aで仕切られ、光源1と窓部2aと密閉部材21とで密閉空間21aが形成されている。

【0021】密閉部材22と密閉部材23とは窓部2bで仕切られ、窓部2aと窓部2bと密閉部材22とで密閉空間22aが形成されている。そして、密閉部材23と鏡筒24とは窓部2cで仕切られ、窓部2bと窓部2cと密閉部材23とで密閉空間23aが形成され、窓部2cと鏡筒24とで密閉空間24aが形成されている。密閉空間22aにはミラー9a、9b、9cが配置され、密閉空間23aにはマスク4を載置するとともに2次元移動可能なマスクステージRSTが配置され、図1ではマスクステージRST上にマスクが載置されている。密閉空間24aには、投影光学系12の各レンズエレメントが配置されている。

【0022】また、投影光学系12とウエハ5との間の空間には、投影光学系12からウエハ5の近傍までの露光光ILの光路のほぼ全域を外部(大気)から密閉する密閉部材18が設けられている。また、図1の投影露光装置には、ウエハの高さ位置(Z方向の位置)を光学的に検出する焦点検出系(14、15)が設けられている。焦点検出系は、ウエハ表面に斜めから計測光17を入射する投光系14と、ウエハ表面で反射された計測光を受光する受光系15とで構成されている。

【0023】受光系15はウエハ表面で反射された計測光と受光光との位置関係を表す信号を主制御部8に出力し、主制御部8はこの信号に基づいてウエハ5の表面が投影光学系12によるマスク4のパターンの像の位置とほぼ一致するように、ウエハステージWSTを高さ方向(2方向)に移動する。主制御部8は光源1、真空ポンプ6、ガス供給系10、ウエハステージWSTのXY方向の移動、マスクステージRSTの移動等を統括的に制御する。

【0024】図2は、この密閉部材18の詳細を示す部分拡大図である。密閉部材18は、投影光学系12からウエハ5の近傍まで露光光1Lの光路に沿って延びた筒状の隔壁(例えば適当な金属等で構成される筒状の隔

壁)19と、隔壁19の側壁に設けられた窓部(計測光17を透過する石英等の透明部材)16a、16bと、 解光光ILを透過する透明部材16c(例えば石英等の 透明部材)とで構成されており、隔壁19と窓部16 a、16bと透明部材16cとで密閉空間18aを形成 している。

【0025】そして、焦点検出系の投光系14からの計 測光17は、窓部16a(計測光17を透過する石英等 の透明部材)、密閉空間18a、透明部材16c及び透 明部材16 c とウエハとの間の大気雰囲気を通ってウエ ハ5の表面に入射し、ウエハ5の表面で反射された計測 光17は透明部材16 c とウエハとの間の大気雰囲気及 び透明部材16c、密閉空間18a、窓部16bを介し て受光系15に入射する。透明部材16cとウエハ5と の間の距離は非常に小さいため、これらの間の大気雰囲 気による露光光ILの酸素による吸収は極めて小さい。 透明部材16cとウエハ5との間の距離は、例えば焦点 検出系の信号に基づいてウエハステージWSTが2軸に 沿って上下することが可能な距離(予め装置として定め たウエハステージWSTの駆動範囲)の2倍程度あるい は投影光学系12の実質的な焦点深度(例えば上下合わ せて20 μ m) の2~3倍程度にすればよい。

【0026】さて、図1に戻って、真空ポンプ6は真空ポンプ61と真空ポンプ62とを有し、密閉空間22 a、23a、24aの各々には配管13aを介して真空ポンプ61が接続され、また、密閉空隔18aには配管20aを介して真空ポンプ62が接続されている。主制御部8は、密閉空間22a、23a、24a内の空気を排気する真空ポンプ61と密閉空間18a内の空気を排気する真空ポンプ62とを独立に制御する。

【0027】また、ガス供給系10は、ガス供給系101とガス供給系102とを有し、200nm以下の遠紫外線(本実施例ではエキシマ光源1より射出された波長193.0nmから波長193.8nmまでの波長幅を有するレーザ光)に対する吸収特性が酸素と比較して小さい不活性ガス(例えば窒素やヘリウム等)を密閉空間21a、22a、23a、24aの各々に配管13bを介してガス供給系101により供給し、これとは独立して密閉空間18aに配管20bを介してこの不活性ガスをガス供給系102により供給する。主制御部8は、ガス供給系101とガス供給系102とを独立に制御する。

[0028] ここで遠紫外線の吸収について図3を参照して説明する。図3は、ArFエキシマレーザ光の光路を窒素によって置換した場合と、置換しなかった場合(ArFエキシマレーザ光の光路が空気中にある場合)とでのArFエキシマレーザ光の強度を比較した図である。図3中、横軸は波長(nm)を示し、縦軸はArFエキシマレーザ光の強度を示している。図3に示すように、エキシマレーザからのレーザ光ILは中心波長19

3. 4nmで193. 0nmから193. 8nm程度ま での波長幅を有するレーザ光(狭帯化しない場合)であ る。

【0029】窒素置換なしの場合(空気中)では、19 3. 0 n m から193. 8 n m 程度までの波長幅内で強 度が低下しており、特にこの波長幅内の特定の波長(ス ペクトル)において強度が大きく低下している。これは 酸素が193.0nmから193.8nm程度までの波 長幅内の光を吸収する特性を有するためで、特にこの波 長幅内の特定の波長(スペクトル)の光を大きく吸収す 10 る特性を有するためである。これに対して、193.0 nmから193.8nm程度までの波長幅内の光を窒素 が吸収する特性は、この波長幅内の光を酸素が吸収する 特性と比較して小さく、この波長幅内の特定の波長城 (スペクトル) の光を大きく吸収する特性は窒素にはな 44

【0030】このように、遠紫外線の特定の波長域の光 が通過する光路の雰囲気を、この特定の波長域を有する 光の吸収特性が酸素と比較して小さな不活性ガスに置換 することにより、酸素が光を吸収することによる光量の 20 損失を小さくするとともに、オゾンの発生(酸素が光を 吸収することにより発生する)を防止することができ る。

【0031】なお、図3では数pm~数+pmの波長幅 を有し、中心波長193.4nmの波長を有する光に狭 帯化したArF狭帯域レーザが示されており、このAr F狭帯域レーザ (波長193.4nm) に対しても酸素 は吸収特性を有するため、光源1から投影光学系12の ウエハ側端部に至るまでの空間(密閉空間21a、22 a、23a、24a)の光路を窒素等の不活性ガスで置 換することが必要となる。さらに、本実施例では、投影 光学系12とウエハ5との間に露光光 ILの光路の大部 分を大気から遮断(密閉)するための密閉部材18を設 けたので、酸素による露光光ILの吸収による不都合 (光量損失、オゾンの発生)を最小限とすることができ る。

【0032】次に、各密閉空間21a、22a、23 a、24a及び18aの大気(酸素)を前述の不活性ガ スに置換する方法について説明する。密閉空間22a、 23a、24a及び18aのガス置換に際しては、密閉 空間22a、23a、24a内の大気を配管13aを介 して真空ポンプ61で真空引きした後、ガス供給系10 1から配管13bを介して不活性ガスを所定の圧力で供 給する。また、密閉空間18a内の大気を配管20aを 介して真空ポンプ62で真空引きした後、ガス供給系1 02から配管20bを介して不活性ガスを所定の圧力で 供給する。

【0033】なお、ガス置換が終了した後も、ガス供給 系101(102)から不活性ガスを供給し続けるとと

のが好ましい。一方、密閉空間21aの場合、密閉部材 21と光源1との接合部において、密閉性(気密性)を 確保することが困難である。しかしながら、窓部2aを 適当な位置に配置することにより密閉空間21aの容頼 を他の密閉空間(例えば22a、23a)と比較して小 さく構成することができる。このため、密閉空間21a 内の大気を強制排気することなくガス供給系101から の不活性ガスを少量ずつ供給する(例えば流しっぱな し) だけで、密閉空間21 a内の大気を不活性ガスで置 換することができる。

【0034】密閉空間21aの場合も、他の密閉空間と 同様に、ガス置換が終了した後も、ガス供給系101か ら不活性ガスを供給し続けるのが好ましい。尚、密閉部 材21と光源1との接合部において密閉性(気密性)を 確保し、他の密閉空間と同様に密閉空間21a内の大気 を強制排気してガス置換を行うようにしてもよい。ま た、密閉空間21aにガスを供給するための配管13b 1と密閉空間21aとの間でガスを循環させるようにし

【0035】また、密閉空間18aは投影光学系12か らウエハ5までの空間内の露光光ILの光路中の大気を ガス置換できるだけの容積があればよく、他の密閉空間 (例えば22a、23a) と比較して小さな容積がよ い。しかしながら、ガスを密閉空間18aに供給するだ けでは、密閉空間18aの圧力が変化してしまう。この ため、主制御部8は、ガス供給密閉空間18a内に配管 20 bを介してガスを供給し続けるようにガス供給系1 02を制御するとともに、配管20aを介してガスを排 気し続けるように真空ポンプ62を制御することによっ て、密閉空間18aの圧力を制御している。

【0036】このように、本実施例にかかる投影露光装 置では、投影光学系12の露光光1Lの出口からウエハ 5の表面の直前までの光路を大気から遮断し、密閉空間 18 a内を不活性ガスで置換することができる。従っ て、焦点検出系の計測光の光路中に不活性ガスの流速の 変動は生じないので、再現性が高くなり精度の高い位置 計測が可能となる。また、通常この種の投影露光装置に はWSTの位置をレーザ光を使って計測する干渉計やウ エハ5のXY平面内での位置をレーザ光等により計測す るアライメントセンサが設けられており、ウエハ5近傍 のこれらの計測光の光路中にも不活性ガスの流速の変動 は生じないので、再現性が高くなり精度の高い位置計測 が可能となる。

【0037】さらに、主制御部8は密閉空間18a内の 圧力を変えたり、供給する不活性ガスを屈折率の異なる ものに変えたり、複数の屈折率を有する不活性ガスの混 合比を変えるように、ガス供給系102を制御し、投影 光学系の結像特性を調整することができる。また、ガス 供給系101は密閉空間23a及び24aへのガス供給 もに配管13a(20a)を介してガスを排気し続ける 50 も独立して行えるものとし、真空ポンプ61も密閉空間 9

23a及び24aからのガス(あるいは大気)の排気を 独立に行えるものとし、マスク4の交換の際は、密閉空 間23aへのガス供給、排気を主制御部8により制御し たり、主制御部8により密閉空間24a内のガスの屈折 率を制御 (密閉空間24a内の圧力を変えたり、供給す る不活性ガスを屈折率の異なるものに変えたり、複数の 屈折率を有する不活性ガスの混合比を変えるように制 御) することにより投影光学系12の結像特性を調整す るようにしてもよい。

場合は窒素と違って、ヘリウムの屈折率が空気の屈折率 と大きく異なるので、窓部16cを凸または凹状として 窓部16cに屈折力を付与して投影光学系12の結像特 性を補正することが望ましい。また、図4に示すように 投影光学系12のウエハ側の端部とウエハ5との間の空 間(露光光ⅠLの光路を含む空間)に窓部16cのよう な透明部材(石英等の透明部材)を設けて、この空間の 大気を透明部材で置換するようにしてもよい。

【0039】また、前述の説明では密閉部材18の一方 は投影光学系12に密着しているが、窓部16cとウエ 20 ハ5との間隔と同程度に、投影光学系12と密閉部材1 8を離して設けるようにしてもよい。このようにすれ ば、メンテナンス等により密閉部材18を交換、取り出 し等する際の作業性が向上する。尚、上述の実施例で は、ArFエキシマレーザを光源とした投影露光装置に ついて本発明を説明したが、酸素に吸収特性を有する波 長域の光(酸素に吸収特性を有する波長域を含む光)を 射出する光源を使用する投影露光装置にも本発明を適用 することができる。酸素に吸収特性を有する波長域の光 としては、例えばYAGレーザや銅蒸気レーザの3次高 30 調波 (波長170 nm) が考えられる。本発明は、ステ ップアンドスキャン方式の投影露光装置にも適用可能で ある。

[0040]

【効果】本発明の第1の投影露光装置によれば、露光光 に遠紫外光(酸素に対して吸収特性を有する波長域を含 む光) を使用しても、酸素による光の吸収、オゾンの発 生を最小限に抑えることができるとともに、投影光学系 ば基板との間の空間もしくはその近傍を各種計測光が通 過しても、揺らぎによる計測誤差が生じない。また、本 発明の第2の投影露光装置では、照明光を透過する透明

【0041】また、本発明の第3の投影露光装置では、 密閉部材は、空間を大気から密閉する隔壁と照明光を透 過する透明部材とを有し、ガス供給系は、隔壁と透明部 材とで形成される密封空間に不活性ガスを供給すること としたので、基板を完全に密封することなく、酸素によ 【0038】尚、不活性ガスとして、ヘリウムを用いる 10 る吸収の不都合が低減される。本発明の第4の投影露光 装置では、密閉部材に、基板に向かって入射する計測光 を透過する第1光透過部と、基板表面で反射された計測 光を透過する第2光透過部とを有することとしたので、 不活性ガスの揺らぎによる計測誤差を生じさせることな く光学的な基板の位置計測を行える。本発明の第5、第 6の投影露光装置では、酸素による露光光の吸収の問題 の解決と投影光学系の結像特性の調整とを同時に行え

10

部材で大気を置換することにより不活性ガスが不要にな

【図面の簡単な説明】

る。

【図1】本発明に好適な投影露光装置の全体構成の概略 を示す図である。

【図2】図1の装置の投影光学系とウエハ部分の拡大図 である。

【図3】遠紫外光の波長域における空気と窒素との吸収 特性の違いを示す図である。

【図4】図2の装置の変形例を示す図である。

【符号の説明】

光源 1

2a、2b、2c 窓部

4 マスク

> ウエハ 5

真空ポンプ 6

主制御部 8

1.0 不活性ガス供給系

12 投影光学系

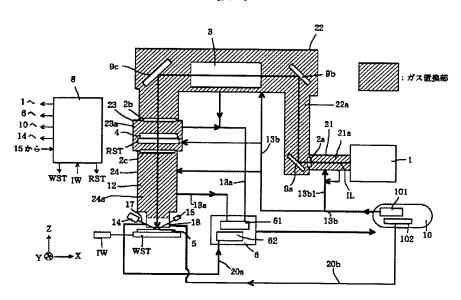
16a、16b 窓部

16c 透明部材

密閉部材 18

21、22、23、24 密閉部材

[図1]



【図2】

